

2T3162A, 2T3162A-5 Кремниевые биполярные р-п-р транзисторы малой мощности

Типовое значение граничной частоты передачи тока $f_T = 700$ МГц
Максимальная рассеиваемая мощность коллектора $P_{Kmax} = 300$ мВт
Максимальное постоянное напряжение коллектор-эмиттер $U_{Kэmax} = 60$ В

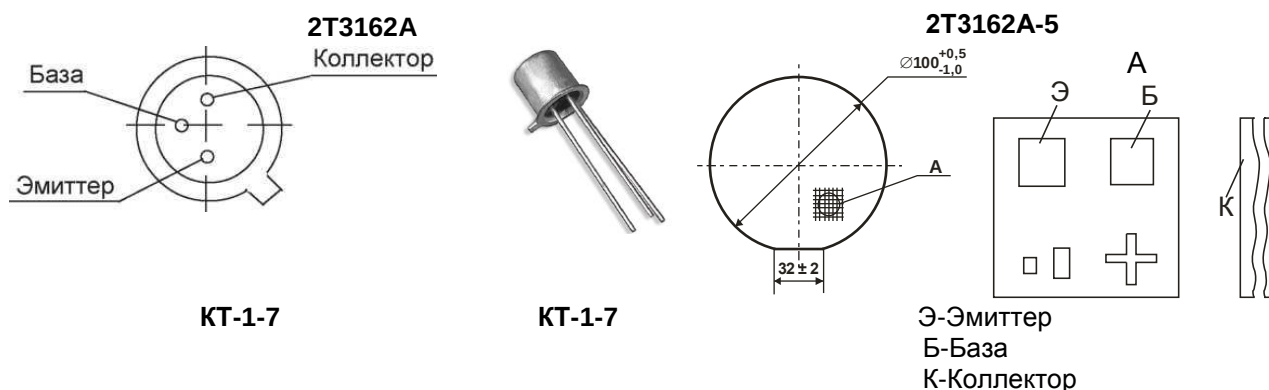
Тип изделия	НомерТУ	Тип корпуса
2T3162A 2T3162A-5	аА0.339.596 ТУ	КТ-1-7 б/к

Кремниевые эпитаксиально-планарные р-п-р высокочастотные транзисторы 2T3162A и структуры 2T3162A-5 предназначены для применения в усилительных и переключающих устройствах радиоэлектронной аппаратуры. Выпускаются в металлостеклянном корпусе с гибкими выводами (2T3162A) и в бескорпусном исполнении на пластине, кристаллы неразделенные (2T3162A-5).

Маркировка транзисторов в соответствии с техническими условиями аА0.339.596 ТУ.

Знаком ОСМ обозначаются изделия повышенной надежности. Размеры кристалла 0,5 x 0,5 мм.

Схема расположения выводов



Основные электрические параметры при температуре: 0°C ÷ + 70°C

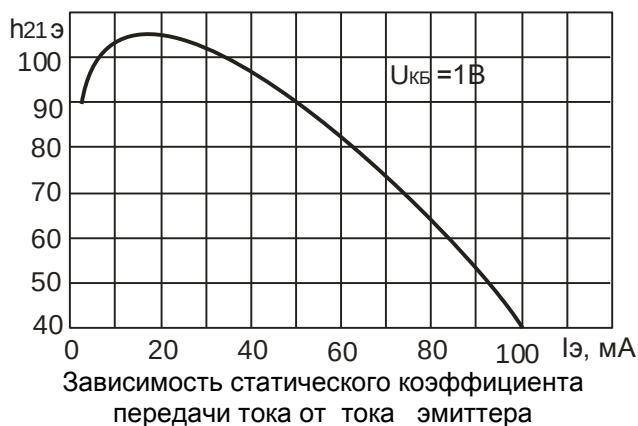
Наименование параметра (режим измерения), единица измерения	Буквенное обозначение	Норма	
		не менее	не более
Обратный ток коллектора ($U_{КБ} = 60$ В), мкА	$I_{КБО}$		0,5
Обратный ток эмиттера ($U_{ЭБ} = 4$ В), мкА	$I_{ЭБО}$		0,5
Статический коэффициент передачи тока ($U_{КБ} = 3$ В, $I_Э = 10$ мА)	$h_{21Э}$	60	200
Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте ($U_{КБ} = 20$ В, $I_К = 10$ мА, $f = 100$ МГц)	$ h_{21Э} $	7	
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер ($I_К = 10$ мА, $I_Б = 1$ мА), В	$U_{КЭнас}$		0,25
Постоянная времени цепи обратной связи на высокой частоте ($U_{КБ} = 10$ В, $I_К = 10$ мА, $f = 30$ МГц), пс	τ_K		150
Время рассасывания ($I_К = 10$ мА, $I_Б = 1$ мА), нс	$t_{РАС}$		100
Емкость коллекторного перехода ($U_{КБ} = 10$ В, $f = 5-10$ МГц), пФ	C_K		5
Емкость эмиттерного перехода ($U_{ЭБ} = 1$ В, $f = 5-10$ МГц), пФ	$C_Э$		6



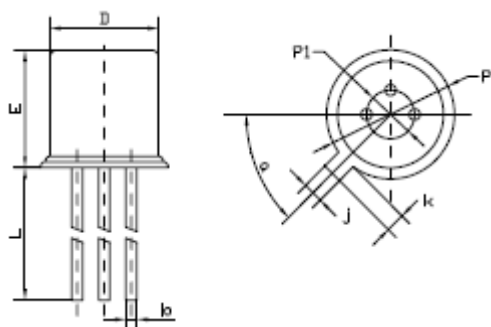
Предельные значения допустимых электрических режимов эксплуатации

Наименование параметра, единица измерения	Буквенное обозначение	2Т3162А, 2Т3162А-5	Примечание
Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-база, В	$U_{КБ\max}$	60	
Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $R_{БЭ} \leq 5 \text{ кОм}$, В	$U_{КЭ\max}$	60	
Максимально допустимое постоянное напряжение эмиттер-база, В	$U_{ЭБ\max}$	4	
Максимально допустимый постоянный ток коллектора, мА	$I_{К\max}$	150	
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора, мВт при T до $+25^\circ\text{C}$ При $T > +25^\circ\text{C}$ до $+85^\circ\text{C}$ $P_{К\max}$ снижается на $2 \text{ мВт} / ^\circ\text{C}$	$P_{К\max}$	300	

Основные типовые зависимости параметров транзисторов



Габаритный чертеж используемого корпуса



Размеры	мм	
	min	max
b		0,5
D		4,95
E		5,3
L	12,5	14,5
P		5,84
P1	2,2	2,6
J	0,94	1,12
k	0,88	1,12
a	40°	50°

Корпус КТ-1-7